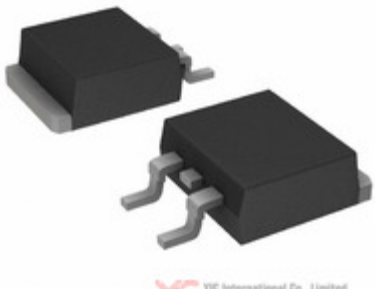



	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHD4N80E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252</p>
	<p>Datenblätter:  SIHD4N80E-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferen von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHD4N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.27 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	622pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.3A (Tc) 69W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)

SIHD4N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD4N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHD4N80E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD3N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>
 <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD3N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD3N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHD4N80E-GE3 Datenblatt	SIHD4N80E-GE3-Datenblätter	SIHD4N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHD4N80E-GE3
SIHD4N80E-GE3 Electronic	SIHD4N80E-GE3-Komponenten	SIHD4N80E-GE3-Verteiler	SIHD4N80E-GE3-Bild	SIHD4N80E-GE3-Teil
SIHD4N80E-GE3 Preis	SIHD4N80E-GE3 Hersteller	SIHD4N80E-GE3 Bild	SIHD4N80E-GE3 Aktie	SIHD4N80E-GE3 Inventar
SIHD4N80E-GE3 Neu	SIHD4N80E-GE3 Original	SIHD4N80E-GE3 garantiert	SIHD4N80E-GE3 RFQ	SIHD4N80E-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited